

## 이온빔에 의한 Cu/Polyimide 표면개질에 따른 접착력향상에 관한 연구

신윤학<sup>†</sup> · 추준식 · 이승우 · 정찬희 · 김명한  
충북대학교 공과대학 재료공학과

### A Study on the Improvement of Adhesion according to the Surface Modification of Cu/Polyimide Films by Ion Beam Irradiation

Youn-Hak Shin<sup>†</sup>, Jun-Sick Chu, Seoung-Woo Lee, Chan-Hoi Jung and Myung-Han Kim

Department of Materials Engineering, Chungbuk National University, 12 Gaesin-dong, Cheongju 361-763, Korea.

(2004년 11월 26일 받음, 2004년 12월 29일 최종수정본 받음)

**Abstract** In microelectronics packaging, the reliability of the metal/polymer interfaces is an important issue because the adhesion strength between dissimilar materials is often inherently poor. The modification of polymer surfaces by ion beam irradiation and rf plasma are commonly used to enhance the adhesion strength of the interface. T-peel strengths were measured using a Cu/polyimide system under varying Ar<sup>+</sup> ion beam irradiation pretreatment conditions. The measured T-peel strength showed reversed camel back shape regarding the fixed metal-layer thickness, which was quite different from the results of the 90° peel test. The elementary analysis suggests that the variation of the T-peel strength is a combined outcome of the plastic bending work of the metal and polymer strips. The results indicate that the peel strength increases with Ar<sup>+</sup> ion beam irradiation energy at the fixed metal-layer thickness.

**Key words** polyimide, surface modification, contact angle, peel test, adhesion.

#### 1. 서 론

폴리이미드(Polyimide)는 열적, 화학적 안정성, 낮은 유전상수, 높은 전기적 저항, 평면적인 구조, 큰유연성을 가지면서도 코팅이나 필름으로의 가공이 용이한 특성이 있다.<sup>1-5)</sup> 이러한 특성을 이용하여 폴리이미드는 전도 금속의 기판으로 사용되거나 또는 TAB(Tape Automated Bonding) 기술이나 FPC(Flexible Printed Circuit)에 응용되고 있다. 현재 중·대형 컴퓨터에 사용되고 있는 다층박막 패키지와 각종 전자제품에 사용되는 Flex 기판 및 TAB과 같은 반도체 패키지에는 폴리이미드 기판이 사용되고 있고, 이 기판에는 제조공정상 수많은 금속/폴리이미드 계면을 함유하고 있는 금속박막 배선이 형성되어 있다.<sup>1-5)</sup> 최근에는 박막을 이용한 소자의 사용범위가 다양화되어 사용 도중 열적, 기계적 응력을 많이 받거나, 또는 온도와 수분이 엄격히 제한된 환경을 벗어나 열악한 환경에 노출되는 전자제품, 자동차, 선박 등의 다양한 제조 산업에 응용되는 경우가 크게 증가되었다. 따라서 제품의 내구성 향상을 위해서는 금속/폴리이미드 계면의 접착력 향상은 필수적이며 이를 개선시

킴으로써 제품의 수명, 신뢰도등은 크게 개선될 수 있다. 보통 박막의 접착성은 기판의 종류, 두께, 온도, 청정도 및 플라즈마처리 정도등 기판조건에 따라 크게 달라지며, 박막의 두께 및 기계적 성질도 이를 좌우한다.<sup>6)</sup>

Ar<sup>+</sup> Ion Beam을 이용한 폴리이미드 기판의 플라즈마 처리시 기판 표면의 화학적 구조 및 형상의 변화가 발생되어 이것이 접착력 향상에 영향이 있음이 알려져 있고, 스퍼터링법은 박막의 형성시 금속의 응축에너지가 높고 스퍼터링 과정에서 생긴 높은 에너지를 가진 원자가 기판 표면을 깨끗하게 할 수 있으며, 기판 표면에 국부적으로 결함을 발생시켜 접착력 향상에 우수한 효과가 있음이 알려져 있다.<sup>6)</sup>

본 연구에서는 폴리이미드 표면을 Ar<sup>+</sup> Ion Beam을 이용해 ion dose량을 변화시켜 표면처리하고, 표면의 화학적 구조변화와 표면형상 변화를 관찰한 후 DC Magnetron Sputtering법을 이용해 Cu박막을 증착하여 Cu/polyimide 사이의 접착력을 향상시키는데 목적을 두고 있다.

#### 2. 실험 방법

본 연구에서 기판으로는 필름 형태로 완전히 curing된 50 μm 두께의 Pyromellitic Dianhydride Oxydianiline

<sup>†</sup>E-Mail : jedoki@hotmail.com

(PMDA-ODA) 폴리이미드 (DuPont의 Kapton H)로써 크기는  $25 \times 25$  mm 사용하였고, 기판 표면의 불순물 및 수분제거를 위해 에틸알코올로 세척 후 진공상태( $10^{-6}$  torr)에서  $200^{\circ}\text{C}$ 로 30분동안 유지시켜 주었다. Cu 박막의 증착은 DC Magnetron Sputtering법을 이용하여 증착하였고, 박막제조시 중요한 변수중에 하나로 알려진 기판 전처리가 박막의 밀착력과 박막형상에 미치는 영향을 알아보기 위해서 박막증착전 기판 표면을  $\text{Ar}^+$  Ion Beam Irradiation방법으로 dose량에 변화를 주며  $5.0 \times 10^{-4}$  torr에서 1 keV, 0.2 mA로 개질하였다. 박막 증착전 초기진공도는  $8 \times 10^{-6}$  torr였으며 증착시 Ar gas를 이용해 진공도  $4.5 \times 10^{-2}$ 에서 DC power 120 W로 2000 Å 증착시켰다.

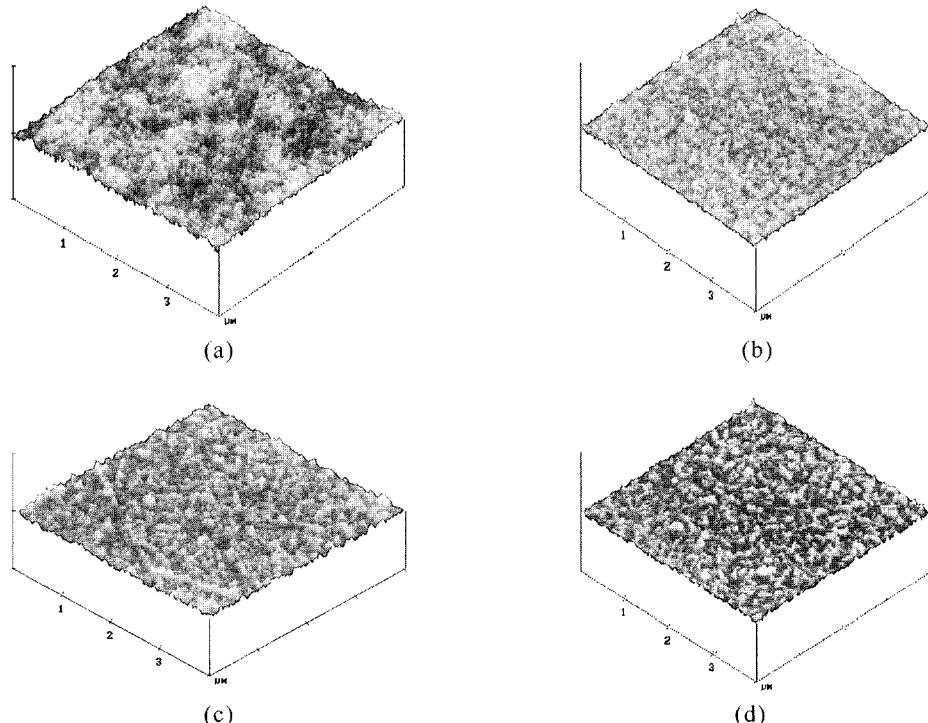
Ion Beam Irradiation에 의한 Cu/polyimide 박막의 표면형상 관찰은 AFM(Park Scientific Instrument사의 Nano scope IIIa)과 Contact Angle(ERMA Contact Angle Meter)을 이용하였으며, 계면의 화학결합 상태를 관찰하기 위해 XPS(VG사의 ESCALAB 210 system)를 이용하였다. AFM의 scan size는 5  $\mu\text{m}$ , 3  $\mu\text{m}$ , 2  $\mu\text{m}$ 로 하였고, 5 point 이상 측정하여 평균값을 취하였다. 접촉각 측정은 필름 표면에 micro syringe로 약 0.2 cc의 물을 떨어뜨렸을 때 시료와의 접촉각으로부터 측정하였다. 이때 사용한 물은 접촉각 측정하기 바로 직전의 정제수를 사용하였으며 dwell time은 5초였다. XPS의 X-ray source로는 Mg K $\alpha$ (1253.6 eV)를 사용하였고 측정조

건은 기본압력  $1.5 \times 10^{-10}$  torr 정도로 초고진공 용기내에서 depth profile을 측정하였다. 증착된 박막의 접착력 측정(정도시험기의 peeling tester)은  $90^{\circ}$  peel test 방법을 이용하여 측정하였고, 이때 사용한 load cell의 용량은 5 kgf $\text{f}$ 이었으며 2 mm/min의 인장속도로 잡아당겨서 peel curve를 구하였다. peel curve에서 균일한 하중이 나올 때의 값을 읽은 후 시편의 너비로 이 값을 나누어 peel 접착강도를 측정하였다.

### 3. 결과 및 고찰

#### 3.1 폴리이미드 Surface Morphology 관찰

표면형상 변화는 박막 증착시 중요한 변수로 작용한다. 이온 조사량이  $1 \times 10^{18}$  ions/ $\text{cm}^2$  이상으로 매우 큰 경우에는 일반적으로 표면의 에칭에 의한 평탄화, groove의 발생, blistering, 원추형 표면형성 등의 변화가 일어남이 보고되고 있다.<sup>7,8)</sup> Fig. 1은 폴리이미드 기판에  $\text{Ar}^+$  ion dose량의 변화에 따른 표면의 형상 변화를 나타낸 AFM image이다. 이온빔 조사 전 (a)에는 표면의 형태는 다소간의 작은 돌출 부분이 있으나 완만한 곡면을 형성하였다. 아르곤 이온빔을 조사한 표면 (b)~(d)에서는 dose량이 증가할 수록 굴곡이 심하게 나타나 마치 여러 개의 산맥이 줄을 지어 있는 것 같은 형상이 나타났다. Chang<sup>9-11)</sup>등은 이러한 원추형 입체의 형성 및 성



**Fig. 1.** The AFM image of the modified polyimide with varying  $\text{Ar}^+$  ion dose : (a)  $\text{Rms}=0.85$  nm(pristine), (b)  $\text{Rms}=3.5$  nm( $1.0 \times 10^{15}$   $\text{Ar}^+/\text{cm}^2$ ), (c)  $\text{Rms}=4.82$  nm( $1.0 \times 10^{16}$   $\text{Ar}^+/\text{cm}^2$ ) and (d)  $\text{Rms}=6.38$  nm( $1.0 \times 10^{17}$   $\text{Ar}^+/\text{cm}^2$ ).

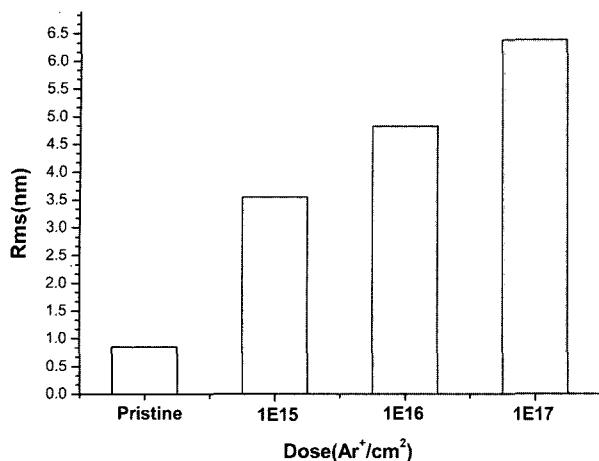


Fig. 2. The surface roughness of the pristine polyimide and modified polyimide with varying ion beam irradiation.

장은 표면 불순물로 인한 mask 역할에 의해 이온빔의 sputtering yield가 변하여 형성된다고 보고하였다. 이러한 원추형 모양은 bulk상태의 폴리이미드와는 다르게 시편이 얇은 film 상태이므로 원추가 누워있는 양상을 나타내었다. 표면조도( $R_{\text{rms}}$ )값은 같은 시료의 5 point를 측정하여 평균값을 얻었고 Fig. 2에 dose량의 변화에 따른 표면조도를 나타내었다. 이온빔 처리전의 표면조도값은 0.85 nm, 아르곤 이온빔 조사시에는 3.55 nm, 4.82 nm 그

리고 6.38 nm로 dose량에 따라 표면조도값이 증가하는 것을 알 수 있었다.

### 3.2 고분자 표면의 화학적 상태 분석

폴리이미드 표면의 화학결합 형태를 관찰하기 위하여 폴리이미드 필름의 XPS spectra를 Fig. 3(a)에 나타내었다. 그 결과 pristine의 경우 결합에너지 287 eV 부근에서 C1s피크, 403 eV 부근에서 N1s피크 그리고 535 eV 부근에서 O1s피크가 나타난 것을 알 수 있었고, dose량이 증가함에 따라 탄소의 함량은 증가하는 반면 질소와 산소의 함량은 감소하는 경향을 보였다. 그리고 Fig. 3(b)의 C1s XPS 스펙트럼은 charge effect때문에 약 2 eV 낮은 에너지 쪽으로 변환하였다.<sup>14)</sup> 284.6 eV에서는 C-C, 285.6 eV에서는 C-O-C 또는 C-N, 286.4 eV에서는 C-O, 287.5 eV에서는 amide, 288.5 eV에서는 C=O의 결합을 확인할 수 있었다. Pristine의 경우 C-C, C-O-C 또는 C-N, C-O, C=O의 결합을 확인할 수 있었고, Dose량이  $1 \times 10^{15}$ 의 경우도 pristine의 화학결합과 비슷한 결합을 가지고 있는 것을 알 수 있다.  $1 \times 10^{16}$ 과  $1 \times 10^{17}$ 의 경우에는 새로운 amide 결합이 생성된 것을 알 수 있었고, 산소와 탄소의 이중결합이 section 된 것을 알 수 있었다. 이는 폴리이미드내의 산소 또는 탄소가 Cu박막 증착시 Cu와 결합을 하여 CuO와 같은 결합을 형성하고, Cu와 강한 접착력을 갖는 것으로 보고되고 있다.<sup>15)</sup>

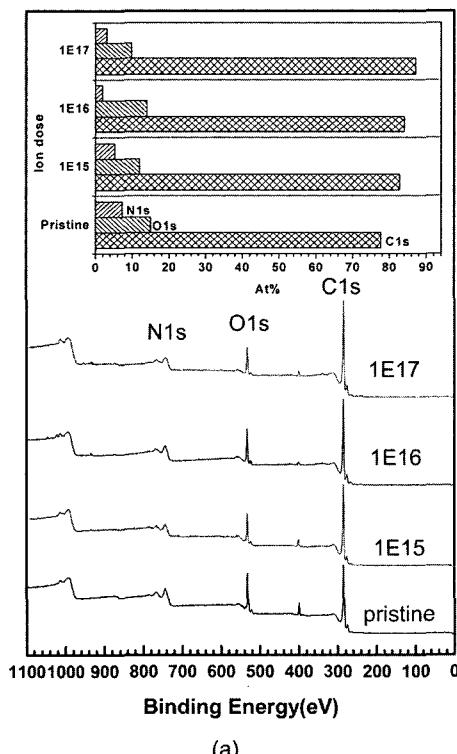
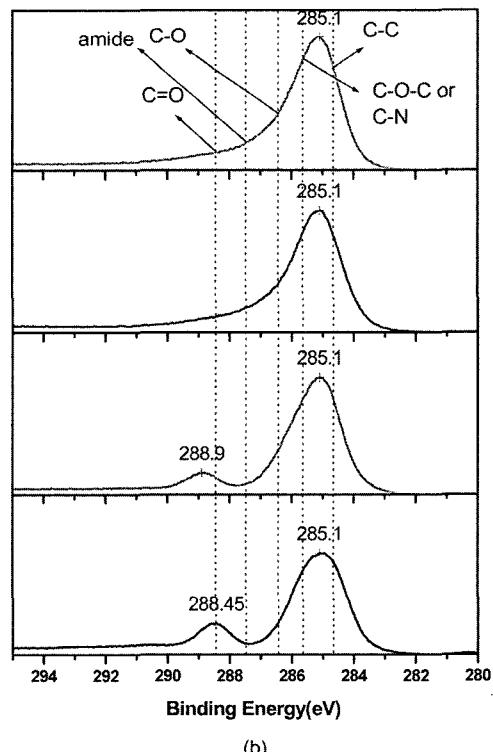


Fig. 3. The XPS spectra of the modified polyimide films by  $\text{Ar}^+$  irradiation : (a) full and (b) C1s.



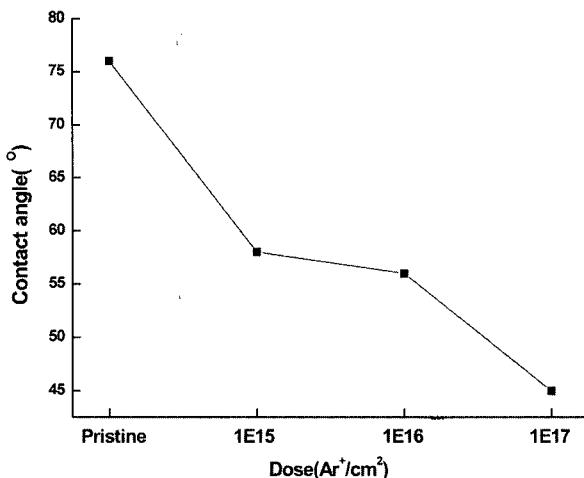


Fig. 4. The change of contact angle of the polyimide according to amount of Ar<sup>+</sup> dose.

### 3.3 폴리이미드 표면의 접촉각 측정

접촉각 측정은 접착, 표면처리 그리고 폴리머 표면 분석과 같은 많은 분야에서 잘 알려진 분석 기술로서, 수 Å 단위의 단일층 변화에도 민감한 표면 분석기술이다.<sup>16)</sup> Fig. 4는 폴리이미드 기판에 Ar<sup>+</sup> ion dose량의 변화에 따른 접촉각 측정을 나타낸 그래프이다. Pristine의 경우 76°의 접촉각을 나타내었고, dose량이 증가함에 따라 접촉각이 58°, 56°, 45°로 서서히 감소하는 경향을 보였다. 이 접촉각은 계속적으로 감소하여 이온의 주입량이 1×10<sup>17</sup>ions/cm<sup>2</sup>일 때 포화되는 것으로 보고되고 있다.<sup>12)</sup> 접촉각이 감소하는 원인은 dose량이 증가함에 따라 표면조도가 증가하여 폴리이미드가 높은 젖음성과 높은 표면 에너지 및 장력을 갖기 때문이고, pristine의 접촉각이 가장 큰 것은 낮은 젖음성과 낮은 표면 에너지 및 장력을 갖기 때문이다. 이러한 이유는 고체 표면에 접촉한 액체의 접촉각은 액체-고체-기체 접합점에서 계면 장력의 상호작용에 의해 결정되는 아래의 Young's equation(Eq. 1)

에 의해 알 수 있었다.

$$\gamma_{LV}\cos\theta = \gamma_{SV} - \gamma_{SL} \quad (\text{Eq. 1})$$

위의 식에서

$\gamma_{SV}$ : 고체-기체 사이의 계면장력

$\gamma_{LV}$ : 액체-기체 사이의 계면장력

$\gamma_{SL}$ : 고체-액체 사이의 계면장력

$\theta$ : 3상의 계면이 만나는 곳에서 액체가 이루는 접촉각

공기중 폴리머에 대하여, 일반적으로  $\gamma_{SV} = \gamma_S$  그리고  $\gamma_{LV} = \gamma_L$ 로 가정된다. 따라서 Young's equation은  $\gamma_S = \gamma_{SL} + \gamma_L \cos\theta$ 와 같이 쓰여진다. Adhesion의 열역학적 이론에 근거하여, 두상 "S"와 "L"사이에 adhesion 자유에너지는 두개의 단위 면적 표면들의 생성과 계면의 분리에 관계된 계의 자유에너지 변화로서 정의된다. 따라서  $\Delta G^a = \gamma_{SL} - \gamma_S - \gamma_L$ 로 나타낼 수 있다. 여기서  $\gamma_S$ 와  $\gamma_L$ 는 각상의 표면에너지이고  $\gamma_{SL}$ 는 두상 사이의 계면에너지이다.

### 3.4 Cu/Polyimide의 접착력 측정

폴리이미드와 Cu film의 접착력을 알아보기 위해 90° peel test로 3회 분석하여 평균값을 측정하였다. Peel 접착력은 박막을 기판에서 분리할 때 요구되는 총 에너지 이므로 분리되는 계면의 결합력 뿐만 아니라 peel test 도중 벗겨지는 금속박막의 소성변형량을 포함하게 된다.<sup>13)</sup> Fig. 5(a)에서 보듯이 박막과 계면의 접착력이 강하면 금속박막과 같은 연성이 큰 박막은 소성변형을 많이 받을 것이고 접착력이 약한 경우 Fig. 5(b)와 같이 박막의 소성변형이 거의 없이 쉽게 분리되므로 접착강도 중 소성변形량의 기여도가 매우 큰 부분을 차지하여 금속박막의 소성변형량이 증가하면 필 접착강도도 증가한다. Fig. 6에서 보면 Ar<sup>+</sup> ion dose량이 증가할 수록 접착력이 증가하는 것을 알 수 있었다. 이는 표면조도의 증가와 접촉각이 작을 수록 소성변형량이 증가하여 접착력이 증가하는 것이며, Dupre equation에 의해서도 알 수 있다.  $W_a = \gamma_{SV} + \gamma_{LV} - \gamma_{SL}$ , 여기서  $W_a$ 는 계면 접착력의 척도로서

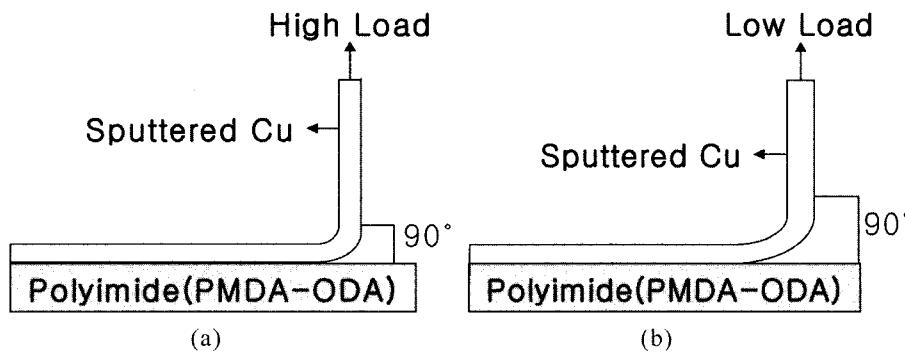


Fig. 5. Schematic diagrams showing the relationship between adhesion strength and plastic deformation : (a) High interfacial bonding strength and (b) low interfacial bonding strength.

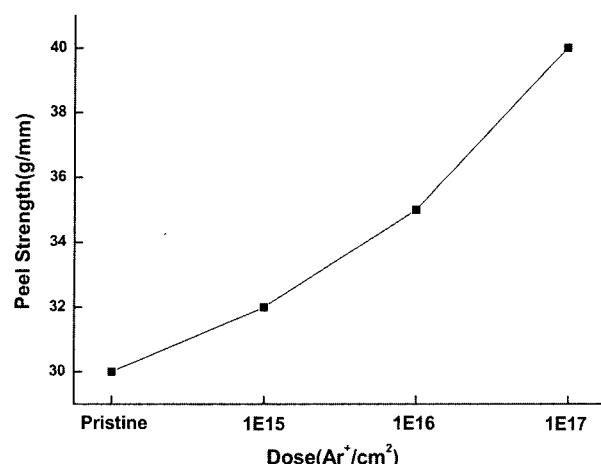


Fig. 6. The change of peel strength according to amount of  $\text{Ar}^+$  dose for the modification of polyimide.

사용할 수 있으며, Dupre equation과 Young's equation을 결합하면  $Wa = \chi_v(1 + \cos\theta)$ 로 나타낼 수 있다.

#### 4. 결 론

1) Ion Beam Irradiation에 의한 표면개질시 표면조도는  $R_{\text{rms}}=0.85 \text{ nm}$ (pristine)에서  $\text{Ar}^+$ 이온 dose량이 증가됨에 따라  $R_{\text{rms}}=3.55 \text{ nm}(1 \times 10^{15})$ ,  $R_{\text{rms}}=4.82 \text{ nm}(1 \times 10^{16})$  그리고  $R_{\text{rms}}=6.38 \text{ nm}(1 \times 10^{17})$ 으로 증가하는 것을 알 수 있었다. 이는  $\text{Ar}^+$ 이온 dose량이 증가함에 따라 폴리이미드 계면에서의 물리적 반응에 의해 표면이 damage를 입게 되는데서 기인된다.

2) 폴리이미드 표면의 화학결합 형태는 284.6 eV에서는 C-C, 285.6 eV에서는 C-O-C 또는 C-N, 286.4 eV에서는 C-O, 287.5 eV에서는 amide, 288.5 eV에서는 C=O의 결합을 나타내었고, dose량이 증가함에 따라 C=O의 결합이 section되면서 Cu박막을 증착했을때 산소 또는 탄소와 결합을 하여 CuO결합이 생기면서 접착력이 증가된 것으로 판단된다.

3) Dose량이 증가할 수록  $76^\circ$ ,  $58^\circ$ ,  $56^\circ$ ,  $45^\circ$ 로 접촉각이 작아지는 것을 알 수 있었다. 이는 폴리이미드 표면이 개질되면서 물과의 친수성을 띠고, 표면 에너지 및

장력이 커지기 때문인 것으로 판단된다.

4) Cu/polyimide의 접착력은 dose량이 증가할 수록 30 gf/mm, 32 gf/mm, 35 gf/mm, 40 gf/mm로 peel strength 값이 증가하는 것을 알 수 있었다. 이는 폴리이미드 계면에서의 물리적인 반응 및 화학적 반응에 의해 표면조도가 증가함에 따라 표면 에너지 및 장력이 커지고 소성변형량이 증가하여 이로 인해 접착력이 증가한다.

#### 참 고 문 헌

1. R. R. Tummala and E. J. Rymaszewski (eds), Microelectronics Packaging Handbook, VNR, New York, 673 (1989).
2. C. C. Chao, K. S. Scholz, J. Leibovitz, M. Cobarruiaz and C. C. Chung, IEEE Trans. Comp. Hybrids Manuf. Tech., **12**, 180 (1989).
3. C. W. Ho, D. A. Chance, C. H. Bajorek and R. E. Acosta, IBM J. Res. Develop., **26**, 286 (1982).
4. D. A. Doane and P. D. Franzon, Multichip Module Technologies and Alternatives, VNR, New York, 403 (1993).
5. J. H. Lau, Handbook of Tape Automated Bonding, VNR, New York 1 (1992).
6. B. Chapman, Glow Discharge Processes, John Wiley & Sons, New York, 201 (1980).
7. B. Navinek, V. Marinkovic, M. Osredkar and G. Carter, Rad. Effects, **3**, 115 (1970).
8. C. J. Beevers and R. S. Nelson, Phil. Mag., **8**, 1189 (1963).
9. S. Han, Surface Modification of Polymers by Ion beam Irradiation, Yonsei Univ, Seoul, 80 (1999).
10. A. D. G. Stewart and Ph. D. Thesis, Cambridge (1962) and Proc. V. Int. Cong. on Electron Microscopy, Philadelphia, Academic press, New York, D12 (1962).
11. C. A. Chang, J. E. E. Baglin, A. G. Schrott and K. C. Lin, Appl. Phys. Lett., **51**(2), 103 (1987).
12. Y. Suzuki, M. Kusakabe and M. Iwaki, Nuclear Instrument and Methods in Physics Research, **B80/81**, 1067 (1993).
13. J. Kim, K. S. Kim and Y. H. Kim, J. Adhesion Sci. Tech., **3**, 175 (1989).
14. G. Beamson and D. Briggs, High Resolution XPS of Organic Polymers, John Wiley & Sons, New York (1992).
15. H. Y. Lee, KAIST, Mat. Sci. Eng., **A311**, 217 (2001).
16. R. J. Good, Contact Angle, Wettability and Adhesion, ed. K. L. Mittal (VSP BV, Utrecht, Netherlands, 1993) p 3.